

	<h2 style="color: red;">FDB0190N807L</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDB0190N807L
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FDB0190N807L.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	FDB0190N807L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 34A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB0190N807LTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	19110pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	249nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 270A (Tc) 3.8W (Ta), 250W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	270A (Tc)

FDB0190N807L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0190N807L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0190N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0190N807L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB0170N607L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>	 <p>FDB016N04ALZ7 FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB020N08BL7 FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB024N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB016N04AL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p>FDB0190N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK</p>	 <p>FDB024N04AL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V D2PAK-7</p>	 <p>FDB0170N607L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0190N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB0190N807L Datenblatt	FDB0190N807L-Datenblätter	FDB0190N807L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0190N807L
FDB0190N807L Electronic	FDB0190N807L-Komponenten	FDB0190N807L-Verteiler	FDB0190N807L-Bild	FDB0190N807L-Teil
FDB0190N807L Preis	FDB0190N807L Hersteller	FDB0190N807L Bild	FDB0190N807L Aktie	FDB0190N807L Inventar
FDB0190N807L Neu	FDB0190N807L Original	FDB0190N807L garantiert	FDB0190N807L RFQ	FDB0190N807L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited